

	<p>VS-GB100TH120N</p> <p>Hersteller-Teilenummer: VS-GB100TH120N</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p> <p>Datenblätter:  VS-GB100TH120N.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-GB100TH120N
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 100A
Supplier Device-Gehäuse	Double INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	833W
Verpackung / Gehäuse	Double INT-A-PAK (3 + 4)
Andere Namen	VSGB100TH120N
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	38 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	8.58nF @ 25V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
detaillierte Beschreibung	IGBT Module Half Bridge 1200V 200A 833W Chassis
Strom - Collector Cutoff (Max)	5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	200A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GB100TH120N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GB100TH120N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GB100TH120N Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GB100TH120N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-GB100TH120U Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 1136W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100NH120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100LP120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 658W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100TP120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 650W INT-A-PAK</p>
 <p>VS-GB100LH120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100LP120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 658W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100TH120U Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 1136W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB100TP120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 650W INT-A-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GB100TH120N Electro-Films (EFI) / Vishay	VS-GB100TH120N Datenblatt	VS-GB100TH120N-Datenblätter	VS-GB100TH120N PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VS-GB100TH120N
VS-GB100TH120N Electronic	VS-GB100TH120N-Komponenten	VS-GB100TH120N-Verteiler	VS-GB100TH120N-Bild	VS-GB100TH120N-Teil
VS-GB100TH120N Preis	VS-GB100TH120N Hersteller	VS-GB100TH120N Bild	VS-GB100TH120N Aktie	VS-GB100TH120N Inventar
VS-GB100TH120N Neu	VS-GB100TH120N Original	VS-GB100TH120N garantiert	VS-GB100TH120N RFQ	VS-GB100TH120N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited